

日 本 国 特 許 庁
PATENT OFFICE
JAPANESE GOVERNMENT

JC929 U.S. PTO

09/774858



別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日
Date of Application: 2000年10月20日

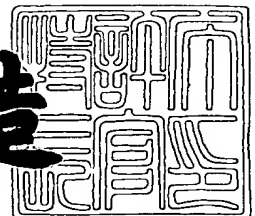
出 願 番 号
Application Number: 特願2000-321713

出 願 人
Applicant(s): シャープ株式会社

2000年11月10日

特許庁長官
Commissioner,
Patent Office

及川耕造



出証番号 出証特2000-3094433

【書類名】 特許願

【整理番号】 00J03569

【提出日】 平成12年10月20日

【あて先】 特許庁長官 及川 耕造 殿

【国際特許分類】 H05K 1/00
H05K 3/00

【発明の名称】 アクティブマトリクス基板およびその製造方法並びに該
基板を用いた表示装置および撮像装置

【請求項の数】 9

【発明者】

【住所又は居所】 大阪府大阪市阿倍野区長池町 2 2 番 2 2 号 シャープ株
式会社内

【氏名】 和泉 良弘

【発明者】

【住所又は居所】 大阪府大阪市阿倍野区長池町 2 2 番 2 2 号 シャープ株
式会社内

【氏名】 近間 義雅

【特許出願人】

【識別番号】 000005049

【氏名又は名称】 シャープ株式会社

【代理人】

【識別番号】 100080034

【弁理士】

【氏名又は名称】 原 謙三

【電話番号】 06-6351-4384

【先の出願に基づく優先権主張】

【出願番号】 特願2000- 49969

【出願日】 平成12年 2月25日

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 003229

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9003082

【ブルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 アクティブマトリクス基板およびその製造方法並びに該基板を用いた表示装置および撮像装置

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

走査電極と信号電極とが格子状に配列されてなる電極配線と、少なくとも該電極配線上に形成され、走査電極および／または信号電極上の所定の領域に開口部を有する絶縁膜と、上記開口部における電極上に積層された金属層とを備えていることを特徴とするアクティブマトリクス基板。

【請求項 2】

上記金属層が湿式メッキ法によって形成されていることを特徴とする請求項 1 記載のアクティブマトリクス基板。

【請求項 3】

上記金属層が、ニッケル膜、銅膜および金膜からなる群より選ばれる少なくとも一種の金属膜を含むことを特徴とする請求項 1 または 2 記載のアクティブマトリクス基板。

【請求項 4】

上記走査電極および／または信号電極が透明導電酸化膜からなることを特徴とする請求項 1、2 または 3 記載のアクティブマトリクス基板。

【請求項 5】

請求項 1 ないし 4 の何れか 1 項に記載のアクティブマトリクス基板と、該アクティブマトリクス基板によって駆動される電気光学媒体とを備えていることを特徴とする表示装置。

【請求項 6】

請求項 1 ないし 4 の何れか 1 項に記載のアクティブマトリクス基板と、該アクティブマトリクス基板によって電荷が読み出される光導電体とを備えていることを特徴とする撮像装置。

【請求項 7】

基板上に、走査電極と信号電極とを格子状に配列して電極配線を形成する工程

と、

少なくとも該電極配線上に、走査電極および／または信号電極上の所定の領域に開口部を有する絶縁膜を形成する工程と、

上記開口部における電極上に、金属層を選択的に形成する工程とを含むことを特徴とするアクティブマトリクス基板の製造方法。

【請求項 8】

上記金属層を、無電解メッキ法によって形成することを特徴とする請求項 7 に記載のアクティブマトリクス基板の製造方法。

【請求項 9】

上記金属層を、電気メッキ法によって形成することを特徴とする請求項 7 に記載のアクティブマトリクス基板の製造方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、例えば、液晶表示装置（LCD）やエレクトロクロミック表示装置（ECD）、エレクトロルミネッセント表示装置（ELD）等のフラットパネルディスプレイ（FPD）；X線撮像装置等のフラットパネルセンサ（FPS）；等の各種装置に好適に使用することができるアクティブマトリクス基板、およびその製造方法、並びに、該基板を用いた表示装置および撮像装置に関するものである。

【0002】

【従来の技術】

従来より、走査電極と信号電極とが格子状に配列されてなるX-Yマトリクス状の電極配線と、該電極配線の交差部毎に設けられたTFT（薄膜トランジスタ）等のスイッチング素子とを組み合わせたり、各スイッチング素子を走査電極毎に順次、走査駆動することが可能なアクティブマトリクス基板が知られている。該アクティブマトリクス基板は、そのフラット性および駆動能力の高さ等の種々の利点を生かすべく、フラットパネルディスプレイやフラットパネルセンサ等の各種装置に応用されている。

【0003】

具体的には、例えば、図6に示すように、アクティブマトリクス基板と、電気光学媒体である液晶とを組み合わせる、アクティブマトリクス型の液晶ディスプレイが開発されている。該ディスプレイは、現在、各種OA機器やAV機器等の幅広い用途・分野に利用されている。また、例えば、図7に示すように、アクティブマトリクス基板と、X線のエネルギーを電荷に変換する光導電体とを組み合わせる、フラットパネル型のX線センサが検討されている。該X線センサは、X線画像データのデジタル化や動画撮影等が容易であるので、X線フィルムとの置き換えを目指して、その開発が盛んに行われている。

【0004】

ところが、上記フラットパネルディスプレイやフラットパネルセンサ等において、その大面積化（大画面化）や高精細化を図った場合には、駆動周波数が高くなると共に、アクティブマトリクス基板における電極配線（バスライン）の抵抗値や寄生容量が増大することとなる。例えばフラットパネルディスプレイにおいては、電極配線の抵抗値や寄生容量が増大すると、駆動信号が遅延する等の影響により、表示の均一性が損なわれるという問題点が生じる。また、例えばフラットパネルセンサにおいては、電極配線の抵抗値や寄生容量が増大すると、光導電体で発生する微弱信号を信号電極を介して読み出す際に、読出信号のS/N比が劣化するという問題点が生じる。

【0005】

そこで、上記の問題点を解消するために、つまり、電極配線の抵抗値を低減するための対策として、電極配線の方法により低い抵抗値を示すアルミニウムを用い、さらに該電極配線の膜厚をより厚くすることが行われている。

【0006】

【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、一般に、アクティブマトリクス基板の電極配線は、スパッタ蒸着等の真空蒸着を行う真空成膜装置を用いて基板上に金属薄膜を成膜した後、エッチングを行うことによって所定の配線形状（パターン）を形成する方法を採用することにより設けられている。このため、電極配線の膜厚をより厚くしようと

すると、つまり、上記の方法を用いて電極配線の厚膜化を図ると、以下の問題点が生じることとなる。

【 0 0 0 7 】

即ち、(1) 真空成膜装置は、一般に枚葉処理を行う構成となっているため、電極配線の厚膜化を図ると、そのスループット（処理能力）が低下し、従ってアクティブマトリクス基板の生産性が低下してしまう；(2) 基板の全面（表面）に金属薄膜を成膜した後、エッチングを行うことによって不要な部分を除去するため、金属薄膜の厚膜化に伴い、エッチングに長時間を要するようになると共に、除去される金属（材料）の量が増加し、無駄が多くなる。

【 0 0 0 8 】

従って、上記従来の方法で、膜厚が 5 0 0 n m を越える電極配線を設けること（厚膜化を図ること）は、生産性やコスト等から鑑みて、事実上、困難（非現実的）である。つまり、上記従来の方法では、アクティブマトリクス基板の電極配線を厚膜化して、該電極配線の抵抗値を低減すること、並びに、これによってフラットパネルディスプレイやフラットパネルセンサ等の大面積化や高精細化を図ることは、事実上、困難であるという問題点を有している。

【 0 0 0 9 】

本発明は、上記従来の問題点に鑑みなされたものであり、その目的は、無駄になる金属の量を抑制すると共に生産性の低下を招来することなく、アクティブマトリクス基板の電極配線を厚膜化して、該電極配線の抵抗値を低減すること、並びに、これによってフラットパネルディスプレイやフラットパネルセンサ等の大面積化や高精細化を図ること、即ち、これら各種装置に好適に使用することができアクティブマトリクス基板、およびその製造方法を提供することにある。また、他の目的は、該基板を用いた表示装置および撮像装置を提供することにある。

【 0 0 1 0 】

【課題を解決するための手段】

本発明のアクティブマトリクス基板は、上記の課題を解決するために、走査電極と信号電極とが格子状に配列されてなる電極配線と、少なくとも該電極配線上

に形成され、走査電極および／または信号電極上の所定の領域に開口部を有する絶縁膜と、上記開口部における電極上に積層された金属層とを備えていることを特徴としている。

【 0 0 1 1 】

上記の構成によれば、走査電極および／または信号電極上に金属層が積層されているので、該金属層によって走査電極および／または信号電極の厚膜化を図ることができる。それゆえ、電極配線の抵抗値が十分に低減された（低抵抗化された）アクティブマトリクス基板を提供することができる。

【 0 0 1 2 】

本発明のアクティブマトリクス基板は、上記の課題を解決するために、さらに、上記金属層が湿式メッキ法によって形成されていることを特徴としている。

【 0 0 1 3 】

上記の構成によれば、金属層の厚膜化を容易に図ることができる。また、バッチ処理による金属層の形成が可能となるので、スループット（処理能力）の低下を抑制することができる。さらに、絶縁膜の開口部における電極上にのみ、金属層を選択的に形成することができるので、該金属層を厚膜化しても、無駄になる金属の量を抑制することができる。

【 0 0 1 4 】

本発明のアクティブマトリクス基板は、上記の課題を解決するために、さらに、上記金属層が、ニッケル膜、銅膜および金膜からなる群より選ばれる少なくとも一種の金属膜を含むことを特徴としている。

【 0 0 1 5 】

上記の構成によれば、例えば無電解メッキ法または電気メッキ法によって、比抵抗が小さい（低抵抗の）金属層を容易に形成することができる。

【 0 0 1 6 】

本発明のアクティブマトリクス基板は、上記の課題を解決するために、さらに、上記走査電極および／または信号電極が透明導電酸化膜からなることを特徴としている。

【 0 0 1 7 】

上記の構成によれば、絶縁膜の開口部における透明導電酸化膜上にのみ、例えばメッキ触媒を選択的に付着させることができるので、無電解メッキ法によって、該透明導電酸化膜上にのみ、金属層を選択的に形成することができる。

【 0 0 1 8 】

本発明の表示装置は、上記の課題を解決するために、上記構成のアクティブマトリクス基板と、該アクティブマトリクス基板によって駆動される電気光学媒体とを備えていることを特徴としている。

【 0 0 1 9 】

上記の構成によれば、表示装置は、電極配線の抵抗値が十分に低減された（低抵抗化された）アクティブマトリクス基板を備えている。従って、表示装置の面積化（大画面化）や高精細化を図った場合においても、駆動信号の遅延を抑制することができるので、表示の均一性を損なうことはない。即ち、駆動信号の遅延を生じることなく、大画面かつ高精細の表示装置を提供することができる。

【 0 0 2 0 】

本発明の撮像装置は、上記の課題を解決するために、上記構成のアクティブマトリクス基板と、該アクティブマトリクス基板によって電荷が読み出される光導電体とを備えていることを特徴としている。

【 0 0 2 1 】

上記の構成によれば、撮像装置は、電極配線の抵抗値が十分に低減された（低抵抗化された）アクティブマトリクス基板を備えている。従って、光導電体内で発生する微小な電荷を、 S/N 比を十分に確保した状態で読み出すことができる。また、上記の構成によれば、撮像装置の面積化（大画面化）や高精細化を図った場合においても、駆動信号の遅延を抑制することができる。即ち、 S/N 比を十分に確保した状態で微小な電荷を読み出すことができ、しかも、駆動信号の遅延を生じることなく、大画面かつ高精細の撮像装置を提供することができる。

【 0 0 2 2 】

本発明のアクティブマトリクス基板の製造方法は、上記の課題を解決するために、基板上に、走査電極と信号電極とを格子状に配列して電極配線を形成する工程と、少なくとも該電極配線上に、走査電極および／または信号電極上の所定の

領域に開口部を有する絶縁膜を形成する工程と、上記開口部における電極上に、金属層を選択的に形成する工程とを含むことを特徴としている。

【 0 0 2 3 】

上記の構成によれば、絶縁膜の開口部における電極上にのみ、金属層を選択的に形成するため、該金属層を形成する際に、所定のパターンニングを施した後にエッチングを行う従来の工程（エッチング工程）が不要となる。また、エッチング工程が不要であるので、金属層を厚膜化しても、無駄になる金属の量を抑制することができる。従って、電極配線の抵抗値が十分に低減された（低抵抗化された）アクティブマトリクス基板を、安価にかつ簡単に製造することができる。

【 0 0 2 4 】

本発明のアクティブマトリクス基板の製造方法は、上記の課題を解決するために、さらに、上記金属層を、無電解メッキ法によって形成することを特徴としている。

【 0 0 2 5 】

上記の構成によれば、無電解メッキ法は、スパッタ蒸着等の真空蒸着法と比較して、バッチ処理による金属層の形成が容易であるので、金属層を厚膜化しても、スループット（処理能力）の低下を抑制することができる。また、大面積を有する基板上に形成された電極上においても、均一な厚みで金属層を形成することができ、かつ、孤立パターン上にも金属層を形成することができる。従って、電極配線の抵抗値が十分に低減された（低抵抗化された）アクティブマトリクス基板を、より一層安価にかつ簡単に製造することができる。

【 0 0 2 6 】

本発明のアクティブマトリクス基板の製造方法は、上記の課題を解決するために、さらに、上記金属層を、電気メッキ法によって形成することを特徴としている。

【 0 0 2 7 】

上記の構成によれば、電気メッキ法は、スパッタ蒸着等の真空蒸着法と比較して、バッチ処理による金属層の形成が容易であるので、金属層を厚膜化しても、スループット（処理能力）の低下を抑制することができる。また、触媒付与等の

メッキ前工程を必要とせずに、簡便に金属層を選択的に形成することができる。従って、電極配線の抵抗値が十分に低減された（低抵抗化された）アクティブマトリクス基板を、より一層安価にかつ簡単に製造することができる。

【 0 0 2 8 】

【発明の実施の形態】

〔実施の形態 1〕

本発明の実施の一形態について図 1 ないし図 2 に基づいて説明すれば、以下の通りである。尚、以下の説明においては、絶縁膜が信号電極上の所定の領域に開口部を有している構成を備えたアクティブマトリクス基板を例に挙げることにする。

【 0 0 2 9 】

本実施の形態にかかるアクティブマトリクス基板は、図 1 および図 2 (g) に示すように、絶縁性基板 1 上に、ゲート電極（走査電極）2、蓄積容量電極（Cs 電極）3、ゲート絶縁膜（誘電体層）4、半導体層 5、ソース電極（信号電極）6、ドレイン電極 7、絶縁保護膜（絶縁膜）8、金属層 12、層間絶縁膜 13、画素電極 15 等が積層されることによって形成されている。そして、ゲート電極 2 やゲート絶縁膜 4、半導体層 5、ソース電極 6、ドレイン電極 7 等で以てスイッチング素子である TFT（薄膜トランジスタ）素子 9 が構成されており、蓄積容量電極 3 やゲート絶縁膜 4、ドレイン電極 7 等で以て電荷蓄積容量（Cs）10 が構成されている。つまり、ソース電極 6 は、信号線としての直線部分と、TFT 素子 9 を構成するための延伸部分とを備えており、ドレイン電極 7 は、TFT 素子 9 と電荷蓄積容量 10 とをつなぐように設けられている。上記絶縁性基板 1 としては、例えば、ガラス基板やプラスチック基板が好適であるが、特に限定されるものではない。

【 0 0 3 0 】

上記ゲート電極 2 並びにソース電極 6 は、絶縁性基板 1 上に格子状に形成（配列）されており、これによって電極配線が構成されている。そして、格子状に形成された該電極配線の交差部（格子点）毎に、上記 TFT 素子 9 が設けられている。また、画素電極 15 は、マトリクス状に多数設けられており、TFT 素子 9

を介して上記ソース電極 6 に接続されている。従って、これら電極配線、T F T 素子 9、画素電極 1 5 等で以て、画素配列層が構成されており、アクティブマトリクス基板は、絶縁性基板 1 上に画素配列層等が形成されることによって構成されている。

【 0 0 3 1 】

ゲート電極 2 および蓄積容量電極 3 の材料としては、例えば、アルミニウム、モリブデン、タンタル、およびこれら金属のうちの少なくとも 1 つを主成分とする各種合金等を用いることができる。またゲート電極 2 および蓄積容量電極 3 として、透明導電酸化膜である I T O (インジウム-錫酸化膜) や $S n O_2$ (錫酸化膜) を用いることもできる。ゲート電極 2 および蓄積容量電極 3 は、例えば、スパッタ蒸着法や無電解メッキ法 (化学メッキ法) 等によって金属膜を成膜した後、所望の形状にパターニングすることによって設けられている。上記金属膜の膜厚は、2 0 0 n m ~ 4 0 0 n m 程度であればよいが、特に限定されるものではない。ゲート電極 2 および蓄積容量電極 3 は、製造工程の簡略化等の観点から、同一材料、同一工程で以て形成されることが望ましい。

【 0 0 3 2 】

ゲート絶縁膜 4 の材料としては、例えば、 $S i N_x$ 、 $S i O_x$ 、 $T a O_x$ 等を用いることができる。また、ゲート絶縁膜 4 として、これら材料からなる膜を積層した積層膜を用いることもできる。ゲート絶縁膜 4 は、例えば、C V D 法 (化学的気相成長法) や陽極酸化法等によって上記材料からなる膜を成膜することによって設けられている。上記膜の膜厚は、2 0 0 n m ~ 5 0 0 n m 程度であればよいが、特に限定されるものではない。尚、ゲート絶縁膜 4 は、ゲート電極 2 並びに蓄積容量電極 3 を覆うようにして設けられており、ゲート電極 2 上に位置する部位が T F T 素子 9 におけるゲート絶縁膜として作用し、蓄積容量電極 3 上に位置する部位が電荷蓄積容量 1 0 における誘電体層として作用する。

【 0 0 3 3 】

半導体層 5 の材料としては、例えば、 $a-Si$ (アモルファスシリコン)、 $p-Si$ (多結晶シリコン)、 $CdSe$ 等を用いることができる。半導体層 5 は、例えば、 $a-Si$ からなる場合には、C V D 法によって $a-Si$ 膜を成膜するこ

とによって設けられている。上記膜の膜厚は、30 nm～100 nm程度であればよいが、特に限定されるものではない。半導体層5は、TFT素子9のチャネルを形成すべく、ゲート電極2上、つまり、ゲート絶縁膜4上におけるTFT素子9が形成される部位に設けられている。

【0034】

ソース電極6およびドレイン電極7の材料としては、例えば、アルミニウム、モリブデン、タンタル、およびこれら金属のうちの少なくとも1つを主成分とする各種合金等を用いることができる。また、ソース電極6およびドレイン電極7として、透明導電酸化膜であるITO（インジウム－錫酸化膜）や SnO_2 （錫酸化膜）を用いることもできる。ソース電極6およびドレイン電極7は、例えば、スパッタ蒸着法等によって上記金属膜を成膜した後、所望の形状にパターニングすることによって設けられている。該形成方法は、大型かつ高精細のアクティブマトリクス基板を製造する場合に好適である。若しくは、ソース電極6およびドレイン電極7は、例えば、スパッタ蒸着法や、ゾルーゲル材料を用いた塗布・焼成法等によってITOを成膜した後、所望の形状にパターニングすることによって設けられている。上記金属膜やITOの膜厚は、100 nm～200 nm程度であればよいが、特に限定されるものではない。そして、蓄積容量電極3上にドレイン電極7が積層されている部位に、電荷蓄積容量10が形成されている。ソース電極6およびドレイン電極7は、製造工程の簡略化等の観点から、同一材料、同一工程で以て形成されることが望ましい。尚、半導体層5とソース電極6およびドレイン電極7との間（界面）には、コンタクト層として、 n^+ 型のa-Si層等を設けることがより好ましい。

【0035】

絶縁保護膜8は、上記電極6・7上、つまり、上記TFT素子9や電荷蓄積容量10等が形成されている絶縁性基板1上に、ほぼ全面（ほぼ全領域）にわたって形成されている。絶縁保護膜8の材料としては、例えば、 SiN_x 、 SiO_x 、ポリイミド樹脂、アクリル樹脂等を用いることができる。また、絶縁保護膜8として、これら材料からなる膜を積層した積層膜を用いることもできる。絶縁保護膜8は、例えば、 SiN_x からなる場合には、CVD法によって SiN_x 膜を

成膜することによって設けられている。上記膜の膜厚は、300nm程度であればよいが、特に限定されるものではない。

【0036】

上記絶縁保護膜8は、その所定位置、つまり、ソース電極6における直線部分上に位置する部位（信号電極上の所定の領域；図1ではハッチングを施した領域）に開口部11aを有しており、ドレイン電極7におけるTF T素子9を構成するための部分を除いた部分上に位置する部位（同図ではハッチングを施した領域）に開口部11bを有している。つまり、上記開口部11aは、TF T素子9を構成するための延伸部分を除いたソース電極6上に、該ソース電極6に沿ってストライプ状に形成（開口）されている。また、開口部11bは、TF T素子9を構成するための部分を除いたドレイン電極7上、より好ましくは電荷蓄積容量10を構成しているドレイン電極7上に形成されている。

【0037】

開口部11a・11bは、絶縁保護膜に所定のレジストパターンを形成した後、エッチングを行うことによって該絶縁保護膜における不要な部分（電極6・7上における開口部が設けられる部分）を除去することによって形成されている。そして、開口部11aにおいては下地であるソース電極6が露出しており、開口部11bにおいては下地であるドレイン電極7が露出している。尚、開口部11aの大きさは、ソース電極6における直線部分上から、はみ出さない大きさであればよい。また、開口部11bの大きさは、ドレイン電極7におけるTF T素子9を構成するための部分を除いた部分上から、より好ましくは電荷蓄積容量10上から、はみ出さない大きさであればよい。

【0038】

金属層12は、上記開口部11a・11bを埋めるようにして形成されており、ソース電極6上およびドレイン電極7上に積層されている。該金属層12は、下地である電極6・7の抵抗値を低減すること（電極6・7を低抵抗化すること）を目的として設けられている。金属層12の材料としては、例えば、ニッケル、銅、金、およびこれら金属を主成分とする各種合金等を用いることができ、そのなかでも比抵抗がより小さい（より低抵抗の）銅および金が好適であり、安価

な金属である銅が最適である。また、ニッケル膜からなる金属層 1 2 は、下地である電極 6・7 との密着性がより良好である。

【 0 0 3 9 】

金属層 1 2 は、例えば湿式メッキ法、即ち、無電解メッキ法または電気メッキ法によって金属膜を成膜することによって設けられている。これにより、金属層 1 2 の厚膜化を容易に図ることができる。また、バッチ処理による金属層 1 2 の形成（成膜）が可能となるので、スループット（処理能力）の低下を抑制することができる。さらに、開口部 1 1 a・1 1 b における電極 6・7 上にのみ、金属層 1 2 を選択的に形成（メッキ成膜）することができるので、該金属層 1 2 を厚膜化しても、無駄になる金属の量を抑制することができる。上記金属膜の膜厚は、電極 6・7 を大幅に低抵抗化することができるように、2 0 0 n m ～ 1 0 0 0 n m 程度であればよいが、絶縁保護膜 8 の膜厚等に応じて設定すればよく、特に限定されるものではない。

【 0 0 4 0 】

無電解メッキ法によって金属層 1 2 を形成する場合には、メッキ触媒と無電解メッキ液とを用いる。該メッキ触媒としては、パラジウム触媒が好適である。

【 0 0 4 1 】

例えば、無電解メッキ法によって成膜された銅の比抵抗は $2 \mu \Omega \text{ cm}$ であるのに対し、従来のスパッタ蒸着法によって成膜された例えばアルミニウムの比抵抗は $4 \mu \Omega \text{ cm}$ である。従って、銅とアルミニウムとを同一の膜厚に成膜した場合には、銅からなる金属層のシート抵抗値は、アルミニウムからなる金属層のシート抵抗値の $1/2$ である。つまり、金属層 1 2 のシート抵抗値を $1/2$ （半分）に低減することができる。また、無電解メッキ法によって膜厚 9 0 0 n m の銅膜を形成した場合と、スパッタ蒸着法によって膜厚 3 0 0 n m のアルミニウム膜を形成した場合とを比較すると、銅からなる金属層のシート抵抗値は、アルミニウムからなる金属層のシート抵抗値の $1/6$ になるので、金属層 1 2 のシート抵抗値を $1/6$ に低減することができる。そして、無電解メッキ法によって金属層 1 2 を形成することにより、スループット（処理能力）を低下させることなくソース電極 6 およびドレイン電極 7 の厚膜化を図ることができ、しかも、無駄になる金属の量

を抑制することができる。それゆえ、従来のスパッタ蒸着法と比較して、電極 6・7 の厚膜化を容易に図ることができ、該電極 6・7 を十分に低抵抗化することができる。即ち、本実施の形態にかかるアクティブマトリクス基板は、上記の方法によって形成された金属層 1 2 を有するので、ソース電極 6 およびドレイン電極 7 の抵抗値を十分に低減することができる。

【0042】

尚、ソース電極 6 およびドレイン電極 7 が I T O であり、金属層 1 2 が銅膜である場合には、I T O と銅膜との間（界面）に、両者の密着性をより一層向上させるために、膜厚が 2 0 0 n m 程度のニッケル膜を設けることができる。ニッケル膜は、I T O との密着性に優れており、無電解メッキ法によって形成することができる。ニッケルは、パラジウム触媒等のメッキ触媒が付着された I T O 上に選択的に析出する。また、該ニッケル膜と銅膜との密着性をより一層向上させるために、ニッケル膜表面に、膜厚が 1 0 n m ～ 3 0 n m 程度の金膜をさらに設けることもできる。金はニッケルに対していわゆる置換メッキが可能であり、これにより金膜を形成することができる。そして、この場合には、金をメッキ触媒として銅膜を形成することができる。つまり、I T O 上にニッケル膜および金膜を積層した後、銅膜を形成する際には、メッキ触媒の作用によって所定の位置に選択的に各メッキを施すことができ、これによって各層（膜）を容易に形成することができる。従って、パターニングに関する工程を追加することなく、上記三層からなる積層構造を容易に形成することができる。以上のように、金属層 1 2 は、ニッケル膜、銅膜および金膜からなる群より選ばれる少なくとも一種の金属膜を含んでいればよく、より具体的には、金属層 1 2 は、例えば、銅からなる単層膜であってもよく、銅膜およびニッケル膜を含む多層膜であってもよく、銅膜、ニッケル膜および金膜を含む多層膜であってもよい。

【0043】

また、金属層 1 2 として、無電解メッキ法によって成膜された銀膜や、銅膜に銀膜を積層してなる多層膜等を用いることもできる。さらに、金属層 1 2 として、電極 6・7 としての I T O 表面に、無電解メッキ法によってニッケル膜や銀膜を成膜した後、その表面に電気メッキ法によって銅膜を成膜してなる多層膜を用

いることもできる。或いは、金属層 1 2 として、電気メッキ法によって形成された銅膜等の金属膜を用いることもできる。電気メッキ法によって金属層 1 2 を形成する場合には、電気メッキ液を用いる。

【 0 0 4 4 】

層間絶縁膜 1 3 の材料としては、例えば、ポリイミド樹脂やアクリル樹脂等の感光性樹脂等を用いることができる。層間絶縁膜 1 3 は、例えば、塗布法等によって上記樹脂を成膜することによって形成されている。樹脂膜の膜厚は、1 0 0 0 n m ~ 4 0 0 0 n m 程度であればよいが、特に限定されるものではない。そして、層間絶縁膜 1 3 における所定位置には、金属層 1 2 を介してドレイン電極 7 と画素電極 1 5 とを短絡させるコンタクトホール 1 4 が形成されている。層間絶縁膜 1 3 の材料として感光性樹脂を用い、該感光性樹脂を絶縁保護膜 8 上に塗布した後、光照射、現像等の所定のパターニング処理を行うことにより、コンタクトホール 1 4 を有する層間絶縁膜 1 3 を容易に形成することができる。ソース電極 6 上に形成された金属層 1 2 は絶縁保護膜 8 と共に層間絶縁膜 1 3 で覆われているので、該金属層 1 2 は層間絶縁膜 1 3 によって保護されている。

【 0 0 4 5 】

画素電極 1 5 の材料としては、例えば、アクティブマトリクス基板を透過型の表示装置に使用する場合には、透明導電酸化膜である I T O 等を用いることができる。また、アクティブマトリクス基板を反射型の表示装置に使用する場合には、反射性に優れたアルミニウムや銀等の金属を成膜して用いることができる。さらに、アクティブマトリクス基板を撮像装置に使用する場合には、上記 I T O 或いはアルミニウムや銀等の金属膜に加えて、低抵抗値を示す、ドーピングが施された半導体膜等の、各種導電材料からなる膜を用いることができる。画素電極 1 5 は、例えば、スパッタ蒸着法等によって上記材料を成膜した後、所望の形状にパターニングすることによって設けられている。上記膜の膜厚は、1 0 0 n m ~ 3 0 0 n m 程度であればよいが、特に限定されるものではない。画素電極 1 5 は、層間絶縁膜 1 3 によって、ソース電極 6 上に形成された金属層 1 2 との電氣的短絡、並びに、静電容量の増大が防止されている。尚、画素電極 1 5 は、図 1 に示すようにゲート電極 2 やソース電極 6 における直線部分に重なり合わないよう

に形成してもよく、また、画素電極の充填率を向上させるために、これら電極 2・6 に重なり合うように形成してもよい。

【0046】

上記構成のアクティブマトリクス基板の製造方法の一例について、図 2 を参照しながら、以下に説明する。尚、アクティブマトリクス基板の製造方法は、下記例示の方法にのみ限定されるものではない。

【0047】

先ず、図 2 (a) に示すように、絶縁性基板 1 上に、スパッタ蒸着法や無電解メッキ法等を採用して金属膜を成膜した後、所望の形状にパターニングすることにより、ゲート電極 2 並びに蓄積容量電極 3 を形成する (第 1 工程)。つまり、ゲート電極 2 および蓄積容量電極 3 を、同一材料、同一工程で以て形成する。

【0048】

次に、同図 (b) に示すように、ゲート電極 2 並びに蓄積容量電極 3 を覆うようにして、絶縁性基板 1 上に、CVD 法や陽極酸化法等を採用して SiN_x 膜等の膜を成膜することにより、ゲート絶縁膜 4 を形成する (第 2 工程)。

【0049】

次に、同図 (c) に示すように、ゲート絶縁膜 4 上における TFT 素子 9 が形成される部位に、例えば CVD 法を採用して a-Si 膜等の膜を成膜することにより、半導体層 5 を形成する。さらにその上に、スパッタ蒸着法等を採用して金属膜等の膜を成膜した後、所望の形状にパターニングすることにより、ソース電極 6 並びにドレイン電極 7 を形成する (第 3 工程)。つまり、ソース電極 6 並びにドレイン電極 7 を、同一材料、同一工程で以て形成する。これにより、ゲート電極 2 およびソース電極 6 からなる電極配線が形成されると共に、TFT 素子 9 並びに電荷蓄積容量 10 が形成される。尚、以下の説明では、ソース電極 6 並びにドレイン電極 7 が ITO である場合を例に挙げる。

【0050】

次いで、同図 (d) に示すように、上記電極 6・7 上に、つまり、絶縁性基板 1 表面のほぼ全面に、例えば CVD 法を採用して膜厚 300 nm の SiN_x 膜等の膜を成膜した後、所望の形状にパターニングを施してエッチングを行うことに

より、開口部 1 1 a ・ 1 1 b を有する絶縁保護膜 8 を形成する（第 4 工程）。尚、以下の説明では、絶縁保護膜 8 が S i N x 膜である場合を例に挙げる。

【 0 0 5 1 】

その後、開口部 1 1 a ・ 1 1 b、つまり、露出しているソース電極 6 並びにドレイン電極 7 の表面に、無電解メッキ法によって金属層 1 2 を形成するために、メッキ触媒であるパラジウム触媒（図示せず）を選択的に付着させる。即ち、上記各工程を実施した後の絶縁性基板 1 を、p H が調整されたパラジウム触媒含有溶液に所定時間、浸漬する。すると、ソース電極 6 並びにドレイン電極 7 である I T O 上にはパラジウム触媒が付着するものの、絶縁保護膜 8 である S i N x 膜上にはパラジウム触媒が付着し難い。従って、露出しているソース電極 6 並びにドレイン電極 7 の表面にのみ、パラジウム触媒が選択的に付着することになる。その後、該絶縁性基板 1 をパラジウム触媒含有溶液から引き上げて水洗し、余分なパラジウム触媒を除去する（第 5 工程）。

【 0 0 5 2 】

尚、メッキ触媒は、I T O に限らず、各種金属に付着し易い性質を備えている。また、I T O 上にパラジウム触媒を選択的に付着させる方法として、いわゆる感光性触媒を用いる方法を採用することもできる。この場合には、上記各工程を実施した後の絶縁性基板 1 の全面（表面）に、光が照射されるとパラジウム触媒を析出する触媒前駆体（感光性触媒）を塗布した後、開口部 1 1 a ・ 1 1 b 部分に光照射を行い、その箇所にパラジウム触媒を析出させればよい。

【 0 0 5 3 】

続いて、上記工程によってパラジウム触媒が付着された絶縁性基板 1 を、無電解メッキ液に所定時間、浸漬し、パラジウム触媒が付着された I T O 上に金属を選択的に析出させる。上記工程によって開口部 1 1 a ・ 1 1 b における I T O 上にのみ、パラジウム触媒が選択的に付着されているので、無電解メッキ法によって該 I T O 上にのみ、金属を選択的に析出させることができる。これにより、同図（e）に示すように、開口部 1 1 a ・ 1 1 b、つまり、露出しているソース電極 6 並びにドレイン電極 7 の表面に、金属層 1 2 を形成する（第 6 工程）。上記第 5 および第 6 工程を実施することにより、金属層 1 2 を形成する際に、所定の

パターンニングを施した後にエッチングを行う従来の工程（エッチング工程）が不要となる。また、エッチング工程が不要であるので、金属層 1 2 を厚膜化しても、無駄になる金属の量を抑制することができる。さらに、無電解メッキ法は、スパッタ蒸着等の真空蒸着法と比較して、バッチ処理による金属層の形成が容易であるので、金属層 1 2 を厚膜化しても、スループット（処理能力）の低下を抑制することができる。無電解メッキ法を採用することにより、大面積を有する絶縁性基板 1 に対しても、均一な膜厚で以て金属層 1 2 を形成することができ、かつ、孤立パターン上にも金属層 1 2 を形成することができる。尚、ITO 上にさらにニッケル膜や金膜を積層する場合には、第 6 工程に先立ち、該第 6 工程に準じて ITO 上に該金属を選択的に析出させた後、第 6 工程を実施して金属層 1 2 を形成する。

【 0 0 5 4 】

一方、開口部 1 1 a ・ 1 1 b、つまり、露出しているソース電極 6 並びにドレイン電極 7 の表面に、電気メッキ法によって金属層 1 2 を形成する場合には、上記第 5 および第 6 工程に代えて下記の工程を実施すればよい。即ち、上記第 1 ～第 4 工程を実施した絶縁性基板 1 を電気メッキ液に浸漬した後、電極 6 ・ 7 に電気メッキ用の電流を所定時間、供給することにより、露出している電極 6 ・ 7 上に銅等の金属を選択的に析出させる工程（第 6' 工程）を実施すればよい。この第 6' 工程を実施することにより、金属層 1 2 を形成する際に、所定のパターンニングを施した後にエッチングを行う従来の工程（エッチング工程）が不要となる。また、触媒付与等のメッキ前工程を必要とせず、簡便に金属層 1 2 を選択的に形成できると共に、エッチング工程が不要であるので、金属層 1 2 を厚膜化しても、無駄になる金属の量を抑制することができる。さらに、電気メッキ法は、スパッタ蒸着等の真空蒸着法と比較して、バッチ処理による金属層の形成が容易であるので、金属層 1 2 を厚膜化しても、スループット（処理能力）の低下を抑制することができる。電気メッキ法を採用することにより、膜質に優れた緻密な金属層 1 2 を得ることができる。

【 0 0 5 5 】

但し、電気メッキ法においては、析出する金属の厚み（膜厚）は電流密度によ

って左右される。このため、例えば電極 6・7 の抵抗値が高いと、電気メッキ用の電流供給源（端子）からの距離に応じて該電極 6・7 による電圧降下が発生し、メッキ時における電流密度に偏り（分布）が生じる。従って、電気メッキ法によって金属層 1 2 を形成する場合には、ソース電極 6 並びにドレイン電極 7 を、ITO ではなく他の金属膜で形成することが望ましい。

【 0 0 5 6 】

次いで、同図（f）に示すように、絶縁保護膜 8 上に、例えば塗布法を採用して樹脂を塗布し、光照射、現像等の所定のパターンニング処理を行うことにより、コンタクトホール 1 4 を有する層間絶縁膜 1 3 を形成する（第 7 工程）。この際、ソース電極 6 上に形成された金属層 1 2 は層間絶縁膜 1 3 で覆われるが、ドレイン電極 7 上に形成された金属層 1 2 はコンタクトホール 1 4 を通して露出することになる。

【 0 0 5 7 】

その後、層間絶縁膜 1 3 上に、例えばスパッタ蒸着法を採用して ITO 等の膜を成膜することにより、画素電極 1 5 を形成する。この際、層間絶縁膜 1 3 に設けたコンタクトホール 1 4 を通じ、金属層 1 2 を介してドレイン電極 7 と画素電極 1 5 とを短絡させる（第 8 工程）。

【 0 0 5 8 】

上記第 1 ～第 8 工程を順に行うことにより、金属層 1 2 を備えたアクティブマトリクス基板が製造される。尚、アクティブマトリクス基板の製造方法は、上記例示の方法にのみ限定されるものではない。

【 0 0 5 9 】

以上のように、本実施の形態にかかるアクティブマトリクス基板は、ゲート電極 2 とソース電極 6 とが格子状に配列されてなる電極配線と、少なくとも該電極配線上に形成され、ソース電極 6 上の所定の領域に開口部 1 1 a を有する絶縁保護膜 8 と、上記開口部 1 1 a におけるソース電極 6 上に積層された金属層 1 2 とを備えている構成である。

【 0 0 6 0 】

上記の構成によれば、ソース電極 6 上に金属層 1 2 が積層されているので、該

金属層 1 2 によってソース電極 6 の厚膜化を容易に図ることができる。それゆえ、電極配線の抵抗値を十分に低減すること（低抵抗化すること）ができる。上記構成のアクティブマトリクス基板は、例えば、大面積化（大画面化）や高精細化が求められている表示装置；微弱信号の読み出しが求められている撮像装置；等の各種装置に好適に使用することができる。

【 0 0 6 1 】

また、金属層 1 2 として銅を用い、絶縁保護膜 8 の材料として C V D 法によって形成される S i N x を用いて第 6 工程を行う場合、銅膜（金属層 1 2）を形成した後、S i N x 膜（絶縁保護膜 8）を形成すると、S i N x 膜を成膜する際の C V D の反応ガス（例えばアンモニアガス）によって銅膜が腐食されるという問題が生じる。しかし、上記構成のように、S i N x 膜を形成した後、銅膜を形成することで、銅膜が腐食するという問題を回避することができる。さらに、S i N x 膜を形成した後に銅膜のメッキ工程を行うため、T F T 素子 9 をメッキ薬液から保護することができる。

【 0 0 6 2 】

〔実施の形態 2〕

本発明の実施の他の形態について図 3 に基づいて説明すれば、以下の通りである。尚、説明の便宜上、前記実施の形態 1 の図面に示した部材（構成）と同一の機能を有する部材（構成）には、同一の符号を付記し、その説明を省略する。

【 0 0 6 3 】

本実施の形態にかかるアクティブマトリクス基板における絶縁保護膜 8 は、開口部 1 1 a ・ 1 1 b を有すると共に、さらに、その所定位置、即ち、図 3 に示すように、ゲート電極 2 における直線部分上に位置する部位（信号電極上の所定の領域；図 3 ではハッチングを施した領域）に開口部 1 1 c を有している。つまり、本実施の形態における絶縁保護膜 8 は、開口部 1 1 a ・ 1 1 b に加えて開口部 1 1 c をさらに有しており、該開口部 1 1 c は、T F T 素子 9 を構成するための延伸部分を除いたゲート電極 2 上に、該ゲート電極 2 に沿ってストライプ状に形成（開口）されている。アクティブマトリクス基板におけるその他の構成部材（構成）は、前記実施の形態 1 のアクティブマトリクス基板と同一である。

【 0 0 6 4 】

上記構成のアクティブマトリクス基板を製造するには、前記実施の形態 1 のアクティブマトリクス基板の製造方法にかかる第 4 ～ 第 6 工程における操作を、以下の通りにすればよい。即ち、第 4 工程において、絶縁性基板 1 表面のほぼ全面に、例えば CVD 法を採用して SiNx 膜等の膜を成膜した後、所望の形状にパターニングを施してエッチングを行うことにより、開口部 11a・11b に加えて開口部 11c を有する絶縁保護膜 8 を形成する。次いで、第 5 工程を実施することにより、開口部 11a・11b・11c、つまり、露出しているゲート電極 2、ソース電極 6 並びにドレイン電極 7 の表面に、メッキ触媒であるパラジウム触媒を選択的に付着させる。続いて、第 6 工程を実施することにより、パラジウム触媒が付着された絶縁性基板 1 を、無電解メッキ液に所定時間、浸漬し、露出しているゲート電極 2、ソース電極 6 並びにドレイン電極 7 の表面に、無電解メッキ法によって金属層 12 を形成する。或いは、第 5 および第 6 工程に代えて第 6' 工程を実施することにより、露出しているゲート電極 2、ソース電極 6 並びにドレイン電極 7 の表面に、電気メッキ法によって金属層 12 を形成する。これにより、製造工程を増加させることなく、本実施の形態にかかるアクティブマトリクス基板を、容易に製造することができる。

【 0 0 6 5 】

以上のように、本実施の形態にかかるアクティブマトリクス基板は、ゲート電極 2 とソース電極 6 とが格子状に配列されてなる電極配線と、少なくとも該電極配線上に形成され、ゲート電極 2 およびソース電極 6 上の所定の領域に開口部 11a・11c を有する絶縁保護膜 8 と、上記開口部 11a におけるソース電極 6 上、並びに開口部 11c におけるゲート電極 2 上に積層された金属層 12 とを備えている構成である。

【 0 0 6 6 】

上記の構成によれば、ゲート電極 2 およびソース電極 6 上に金属層 12 が積層されているので、該金属層 12 によってゲート電極 2 およびソース電極 6 の厚膜化を容易に図ることができる。それゆえ、電極配線の抵抗値を十分に低減すること（低抵抗化すること）ができる。

【 0 0 6 7 】

尚、絶縁保護膜 8 は、開口部 1 1 b ・ 1 1 c のみを有する構成（開口部 1 1 a を有しない構成）であってもよい。即ち、絶縁保護膜 8 は、ゲート電極 2 上およびソース電極 6 上の少なくとも一方に位置する部位に、開口部を有していればよい。

【 0 0 6 8 】

〔実施の形態 3〕

本発明の実施のさらに他の形態について図 4 に基づいて説明すれば、以下の通りである。尚、説明の便宜上、前記実施の形態 1 の図面に示した部材（構成）と同一の機能を有する部材（構成）には、同一の符号を付記し、その説明を省略する。

【 0 0 6 9 】

本実施の形態にかかる撮像装置は、X 線を光導電体で電荷に直接変換する直接変換型の X 線センサ（X 線撮像装置）であり、図 4 に示すように、前記実施の形態 1 若しくは形態 2 で製造されたアクティブマトリクス基板 2 0 と、該アクティブマトリクス基板 2 0 によって電荷が読み出される光導電体 2 1 とを備えている。即ち、本実施の形態にかかるフラットパネル型の X 線センサは、アクティブマトリクス基板 2 0 のほぼ全面に、つまり、該アクティブマトリクス基板 2 0 にマトリクス状に多数設けられた画素電極 1 5 …上に、X 線を吸収することによって電荷（電子－正孔対）を発生する光導電体 2 1 が積層され、該光導電体 2 1 上に、バイアス電極 2 2 が積層されて構成されている。そして、画素電極 1 5 等で構成される画素配列層が、X 線画像の検出領域となっている。上記バイアス電極 2 2 には、高圧電源が電氣的に接続されている。また、アクティブマトリクス基板 2 0 に設けられたソース電極 6 には、外部回路であるアンプ回路がそれぞれ接続されている。

【 0 0 7 0 】

光導電体 2 1 の材料としては、X 線に対する感度が良好であり、大面積を有するアクティブマトリクス基板上に容易に成膜することができる材料、例えば、a - S e （アモルファスセレン）、C d T e、C d Z n T e、P b I₂ 等の半導体

を用いることができる。なかでも、a-Seは、X線吸収率が高く、X線-電荷変換効率に優れており、例えば真空蒸着法を採用することにより、比較的低い温度で、アクティブマトリクス基板20上に直接、成膜することができる。光導電体21の膜厚は、例えばa-Seを用いた場合には500 μ m~1500 μ m程度であればよいが、特に限定されるものではない。

【0071】

バイアス電極22の材料としては、例えば、白金、金、ITO等を用いることができる。尚、バイアス電極22の形成方法や厚さ等は、特に限定されるものではない。

【0072】

上記構成におけるX線センサの駆動原理について、以下に説明する。X線センサにバイアス電極22側からX線が照射されると、X線を吸収することによって光導電体21内で電荷（電子-正孔対）が発生する。発生した電荷（図4の場合には正孔）は、高圧電源からバイアス電極22に印加された電界により、アクティブマトリクス基板20の画素電極15に導かれ、該画素電極15に接続されている電荷蓄積容量10に蓄積される。そして、アクティブマトリクス基板20のゲート電極2が線順次、走査駆動されてTFT素子9のON/OFFが制御されることにより、各電荷蓄積容量10に蓄積された電荷は、TFT素子9およびソース電極6を介して信号として外部に読み出される。その後、読み出された信号は、アクティブマトリクス基板20の外部に設けられたアンプ回路によって増幅され、画像信号として取り出される。これにより、X線センサに照射されたX線の二次元的な分布を、画像信号として得ることができる。

【0073】

一般にX線センサにおいては、X線の吸収によって光導電体内で発生する微小な電荷を、S/N比を十分に確保した状態で外部に読み出す必要がある。それゆえ、アクティブマトリクス基板のソース電極等については、光導電体で発生する微弱信号を読み出すために、十分な低抵抗化が求められている。これに対し、前記実施の形態1若しくは形態2で製造されたアクティブマトリクス基板20においては、ソース電極6等に金属層12が積層されているので、該ソース電極6等

が十分に低抵抗化されている。従って、光導電体 21 内で発生する微小な電荷を、S/N 比を十分に確保した状態で読み出すことができる。また、X 線センサの大面積化（大画面化）や高精細化を図った場合においても、駆動信号の遅延を抑制することができる。即ち、S/N 比を十分に確保した状態で微小な電荷を読み出すことができ、しかも、駆動信号の遅延を生じることなく、大画面かつ高精細の X 線センサを提供することができる。

【 0 0 7 4 】

尚、撮像装置は、上記構成の直接変換型の X 線センサにのみ限定されるものではなく、例えば、蛍光層と光導電体とを備え、X 線を蛍光層で光に一旦変換した後、該光を光導電体で電荷に変換する間接変換型の X 線センサ（X 線撮像装置）であってもよい。

【 0 0 7 5 】

〔実施の形態 4〕

本発明の実施のさらに他の形態について図 5 に基づいて説明すれば、以下の通りである。尚、説明の便宜上、前記実施の形態 1 の図面に示した部材（構成）と同一の機能を有する部材（構成）には、同一の符号を付記し、その説明を省略する。

【 0 0 7 6 】

本実施の形態にかかる表示装置は、フラットパネル型の液晶パネル（液晶表示装置）であり、図 5 に示すように、前記実施の形態 1 若しくは形態 2 で製造されたアクティブマトリクス基板 20 と、対向基板 29 と、両基板 20・29 間に充填された液晶層 25 とを備えている。即ち、本実施の形態にかかる透過型の液晶パネルは、アクティブマトリクス基板 20 のほぼ全面に、つまり、該アクティブマトリクス基板 20 にマトリクス状に多数設けられた画素電極 15…上に、アクティブマトリクス基板 20 によって駆動される電気光学媒体としての液晶層 25 が積層され、該液晶層 25 上に対向基板 29 が積層されて構成されている。該液晶層 25 は、基板 20・29 の周囲に枠状に設けられたシール材 31 によってシール（封入）されている。そして、画素電極 15 等で構成される画素配列層が、液晶パネルの画像表示領域となっている。

【 0 0 7 7 】

上記アクティブマトリクス基板 2 0 の背面（画素電極 1 5 等が設けられている側とは異なる側）には、偏光板 2 6 が取り付けられている。上記対向基板 2 9 の対向面（液晶層側）には、赤・緑・青（R・G・B）のカラーフィルタ 2 8 と、共通電極 2 7 とがこの順に取り付けられている。また、上記対向基板 2 9 の背面（液晶層側とは異なる側）には、偏光板 3 0 が取り付けられている。そして、アクティブマトリクス基板 2 0 の背面側における所定位置には、バックライト（図示せず）が設けられている。該バックライトから照射される光（バックライト光）は、液晶パネルを透過して対向基板 2 9 の背面側に到達し、これにより、各種表示がなされるようになっている。従って、上記液晶パネルは、対向基板 2 9 の背面側が表示面となっている。

【 0 0 7 8 】

上記構成における液晶パネルの駆動原理について、以下に説明する。アクティブマトリクス基板 2 0 のゲート電極 2 が線順次、走査駆動されて T F T 素子 9 の ON / OFF が制御されることにより、画素電極 1 5 には、表示信号に応じた電圧が、上記 T F T 素子 9 およびソース電極 6 を介して印加される。そして、該画素電極 1 5 および共通電極 2 7 によって液晶層 2 5 に表示信号に応じた電圧が印加されると、液晶パネルを透過するバックライト光は、液晶の電気光学特性によって変調される。これにより、液晶パネルは、表示信号に応じた画像表示を行うことができる。

【 0 0 7 9 】

一般にアクティブマトリクス型の液晶パネルにおいては、その大面積化（大画面化）や高精細化を図った場合には、駆動信号が遅延する等の影響により、表示の均一性が損なわれるという問題点を有している。それゆえ、アクティブマトリクス基板のゲート電極やソース電極等については、駆動信号の遅延を抑制するために、十分な低抵抗化が求められている。これに対し、前記実施の形態 1 若しくは形態 2 で製造されたアクティブマトリクス基板 2 0 においては、ゲート電極 2 やソース電極 6 等に金属層 1 2 が積層されているので、該電極 2 ・ 6 等が十分に低抵抗化されている。従って、液晶パネルの大面積化や高精細化を図った場合に

においても、駆動信号の遅延を抑制することができるので、表示の均一性を損なうことはない。即ち、駆動信号の遅延を生じることなく、大画面かつ高精細の液晶パネルを提供することができる。

【 0 0 8 0 】

尚、表示装置は、上記構成の透過型の表示装置にのみ限定されるものではなく、例えば、画素電極に反射性を備えた金属を用いた反射型の表示装置であってもよい。また、表示装置は、偏光板を用いない方式、例えば、ゲスト・ホスト型表示方式や光散乱（分散）型表示方式等の方式を採用した表示装置であってもよい。さらに、表示装置は、液晶以外の電気光学媒体、例えば、有機EL（エレクトロルミネッセンス）材料や、電気泳動材料、エレクトロクロミック材料等の材料を用いた表示装置であってもよい。

【 0 0 8 1 】

上記実施形態1～4においては、アクティブマトリクス基板の走査電極および／または信号電極の厚膜化を図る方法として、無電解メッキ法や電気メッキ法を用いて選択的に金属層を形成する場合を例に挙げて説明した。これらの方法は、従来の技術の欄に示した以下の2つの課題を同時に解決するために、最も適した方法である。

- (1) 真空成膜装置は、一般に枚葉処理を行う構成となっているため、電極配線の厚膜化を図ると、そのスループット（処理能力）が低下し、従ってアクティブマトリクス基板の生産性が低下してしまう、
- (2) 基板の全面（表面）に金属薄膜を成膜した後、エッチングを行うことによって不要な部分を除去するため、金属薄膜の厚膜化に伴い、エッチングに長時間を要するようになると共に、除去される金属（材料）の量が増加し、無駄が多くなる。

【 0 0 8 2 】

しかしながら、上記(2)の課題のみを解決する目的であれば、金属層を選択的に形成する方法は上記方法に限定されるものではない。例えばCVD法等の乾式成膜方法を用いて選択的に金属層を形成する方法等を用いることも可能である。

【 0 0 8 3 】

具体的には、例えば、下地電極である電極 6・7 に T i N を用い、その上層の絶縁保護膜 8 に酸化膜を用いると、絶縁保護膜 8 の開口部 1 1 a・1 1 b から露出した T i N 膜の表面にのみ、選択的に C V D 法で銅膜を成膜することができる。また、電極 6・7 を有する基板の表面全面に界面活性剤を塗布し、光照射により電極 6・7 の表面の所定の領域のみ選択的に該界面活性剤を除去することで、その除去された領域にのみ、C V D 法で銅膜を成膜することもできる。

【0 0 8 4】

【発明の効果】

本発明のアクティブマトリクス基板は、以上のように、走査電極および／または信号電極上の所定の領域に開口部を有する絶縁膜と、上記開口部における電極上に積層された金属層とを備えている構成である。それゆえ、金属層によって走査電極および／または信号電極の厚膜化を図ることができるので、電極配線の抵抗値が十分に低減された（低抵抗化された）アクティブマトリクス基板を提供することができるという効果を奏する。

【0 0 8 5】

本発明のアクティブマトリクス基板は、以上のように、上記金属層が湿式メッキ法によって形成されている構成である。それゆえ、金属層の厚膜化を容易に図ることができる；スループット（処理能力）の低下を抑制することができる；金属層を厚膜化しても、無駄になる金属の量を抑制することができる；という種々の効果を奏する。

【0 0 8 6】

本発明のアクティブマトリクス基板は、以上のように、上記金属層が、ニッケル膜、銅膜および金膜からなる群より選ばれる少なくとも一種の金属膜を含む構成である。それゆえ、比抵抗が小さい（低抵抗の）金属層を容易に形成することができるという効果を奏する。

【0 0 8 7】

本発明のアクティブマトリクス基板は、以上のように、上記走査電極および／または信号電極が透明導電酸化膜からなる構成である。それゆえ、無電解メッキ法によって、該透明導電酸化膜上にのみ、金属層を選択的に形成することができ

るという効果を奏する。

【 0 0 8 8 】

本発明の表示装置は、以上のように、上記構成のアクティブマトリクス基板と、該アクティブマトリクス基板によって駆動される電気光学媒体とを備えている構成である。それゆえ、駆動信号の遅延を生じることなく、大画面かつ高精細の表示装置を提供することができるという効果を奏する。

【 0 0 8 9 】

本発明の撮像装置は、以上のように、上記構成のアクティブマトリクス基板と、該アクティブマトリクス基板によって電荷が読み出される光導電体とを備えている構成である。それゆえ、S/N比を十分に確保した状態で微小な電荷を読み出すことができ、しかも、駆動信号の遅延を生じることなく、大画面かつ高精細の撮像装置を提供することができるという効果を奏する。

【 0 0 9 0 】

本発明のアクティブマトリクス基板の製造方法は、以上のように、走査電極および／または信号電極上の所定の領域に開口部を有する絶縁膜を形成する工程と、上記開口部における電極上に、金属層を選択的に形成する工程とを含む構成である。それゆえ、電極配線の抵抗値が十分に低減された（低抵抗化された）アクティブマトリクス基板を、安価にかつ簡単に製造することができるという効果を奏する。

【 0 0 9 1 】

本発明のアクティブマトリクス基板の製造方法は、以上のように、上記金属層を、無電解メッキ法によって形成する構成である。それゆえ、大面積を有する基板上に形成された電極上においても、均一な厚みで金属層を形成することができ、かつ、孤立パターン上にも金属層を形成することができるという効果を奏する。

【 0 0 9 2 】

本発明のアクティブマトリクス基板の製造方法は、以上のように、上記金属層を、電気メッキ法によって形成する構成である。それゆえ、触媒付与等のメッキ前工程を必要とせずに、簡便に金属層を選択的に形成することができるという効

果を奏する。

【図面の簡単な説明】

【図 1】

本発明の実施の一形態におけるアクティブマトリクス基板の要部を示すものであり、或る 1 つの画素の概略の構成を示す平面図である。

【図 2】

(a) ～ (g) は、図 1 における A - A 線矢視断面図を用いて上記画素の製造工程を順に説明する説明図である。

【図 3】

本発明の実施の他の形態におけるアクティブマトリクス基板の要部を示すものであり、或る 1 つの画素の概略の構成を示す平面図である。

【図 4】

本発明の実施の一形態におけるアクティブマトリクス基板を用いた X 線センサ (X 線撮像装置) の概略の構成を示す断面図である。

【図 5】

本発明の実施の一形態におけるアクティブマトリクス基板を用いた液晶パネル (表示装置) の概略の構成を示す断面図である。

【図 6】

一般的なアクティブマトリクス型の液晶ディスプレイの概略の構成を示す、(a) は分解斜視図であり、(b) はその等価回路である。

【図 7】

一般的なフラットパネル型の X 線センサの概略の構成を示す説明図である。

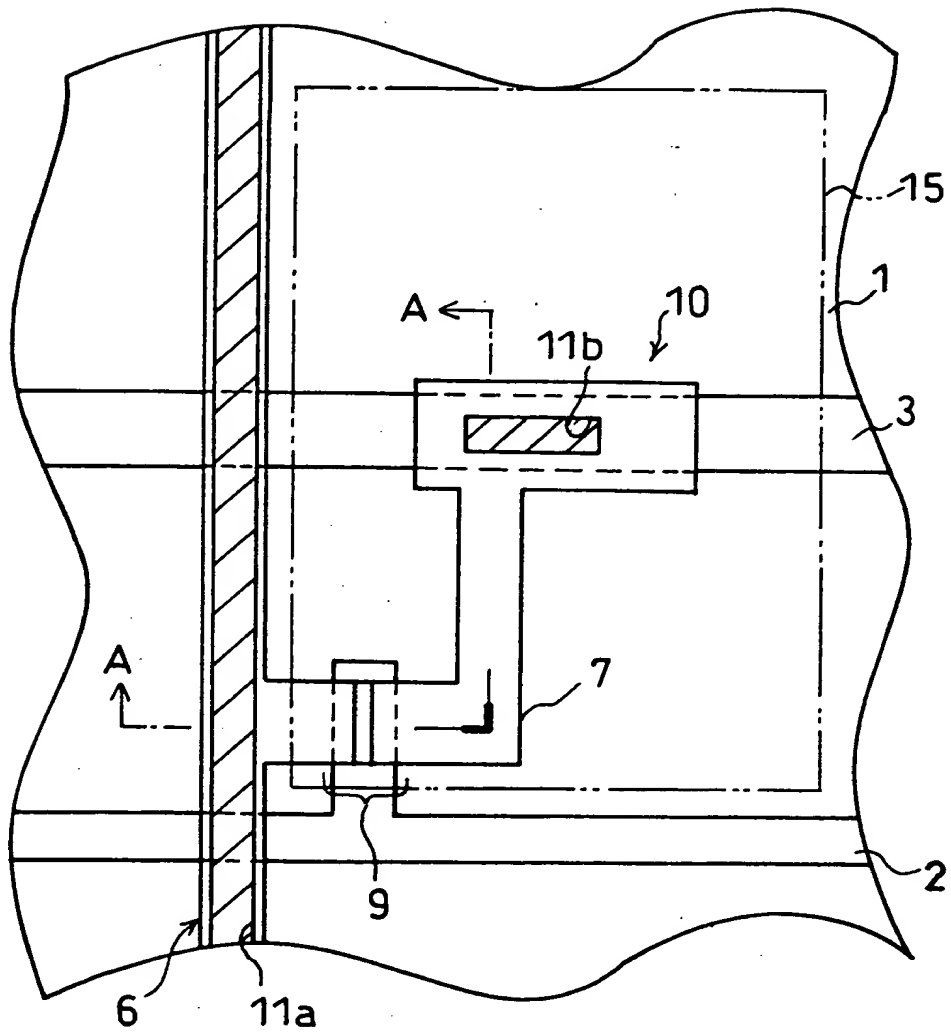
【符号の説明】

- 1 絶縁性基板
- 2 ゲート電極 (走査電極、電極配線)
- 3 蓄積容量電極 (C s 電極)
- 4 ゲート絶縁膜 (誘電体層)
- 6 ソース電極 (信号電極、電極配線)
- 7 ドレイン電極

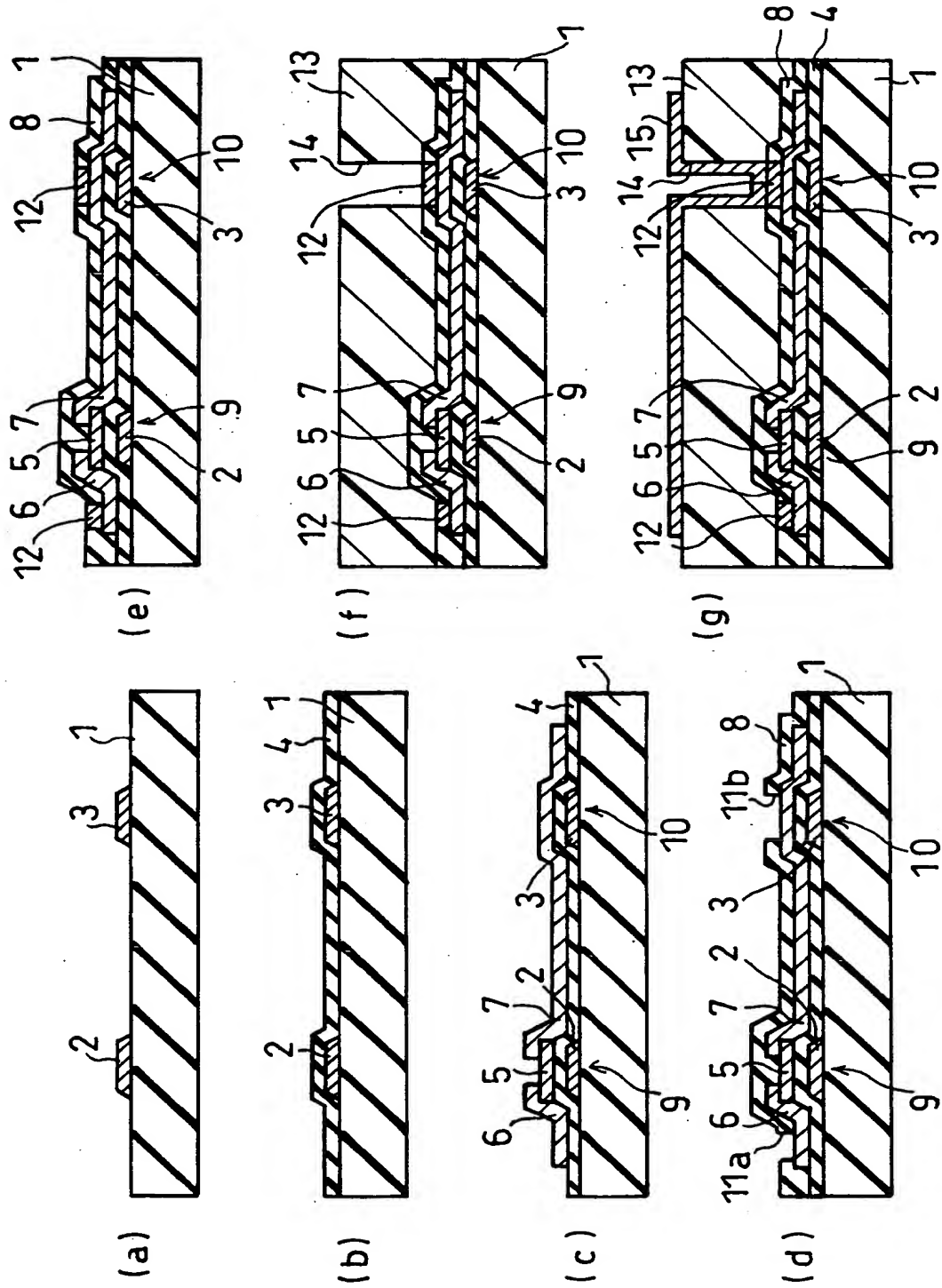
- 8 絶縁保護膜（絶縁膜）
- 9 TFT素子（スイッチング素子）
- 10 電荷蓄積容量（Cs）
- 11 a, 11 b, 11 c 開口部
- 12 金属層
- 15 画素電極
- 20 アクティブマトリクス基板
- 21 光導電体
- 25 液晶層（電気光学媒体）

【書類名】 図面

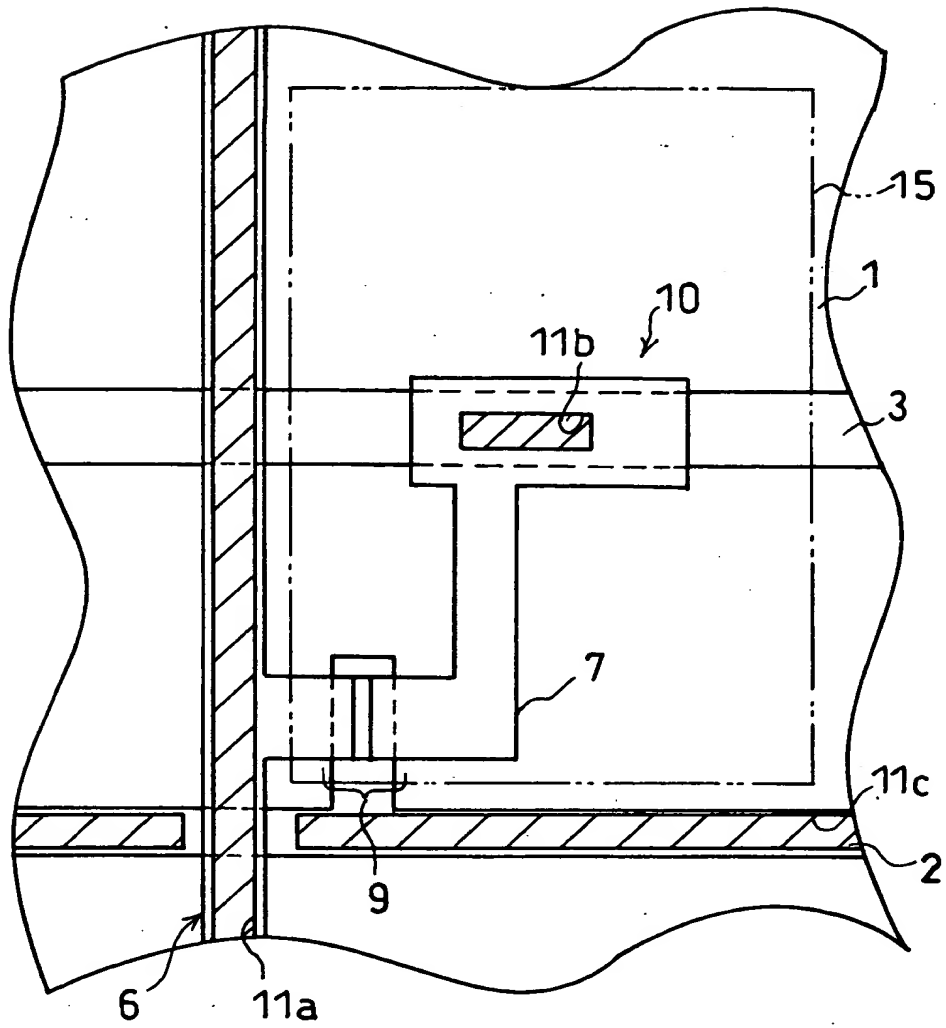
【図 1】



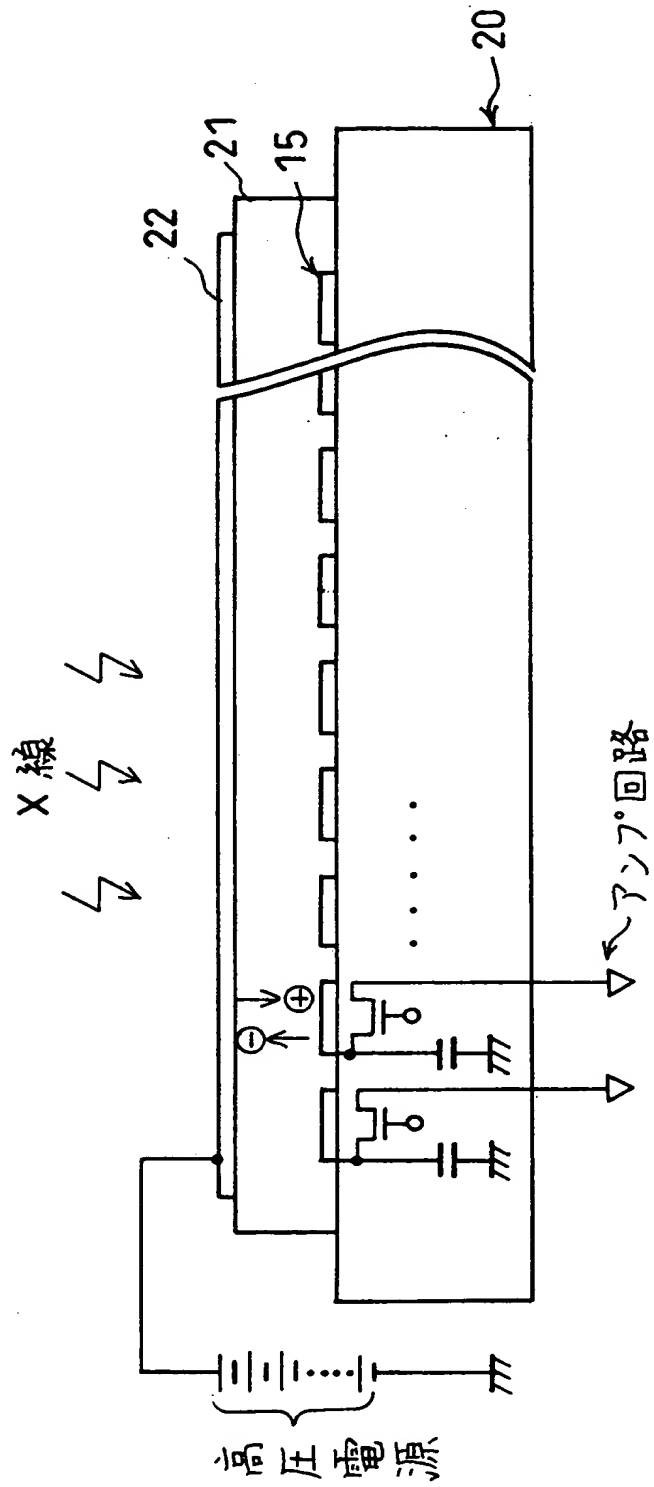
【図 2】



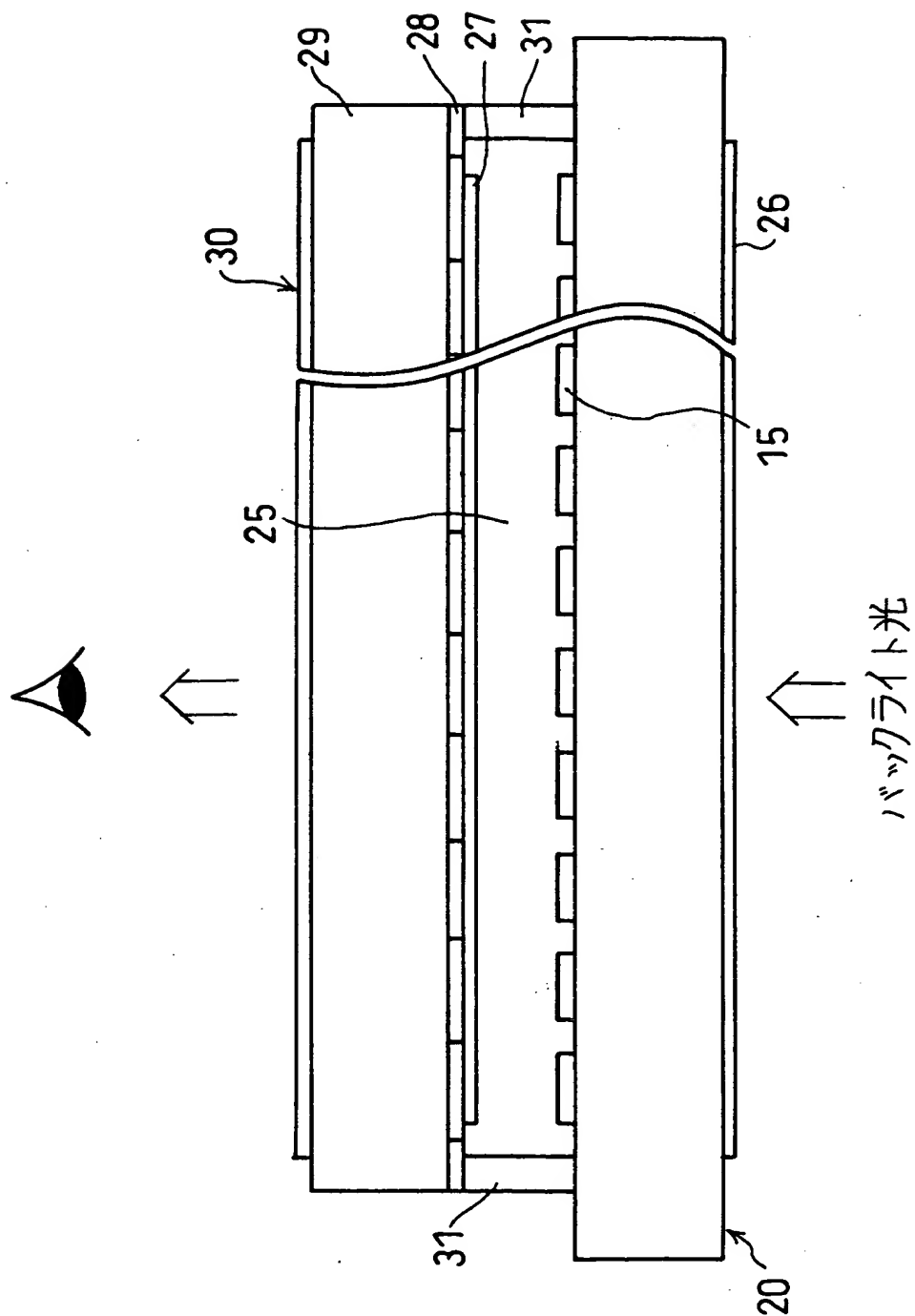
【図3】



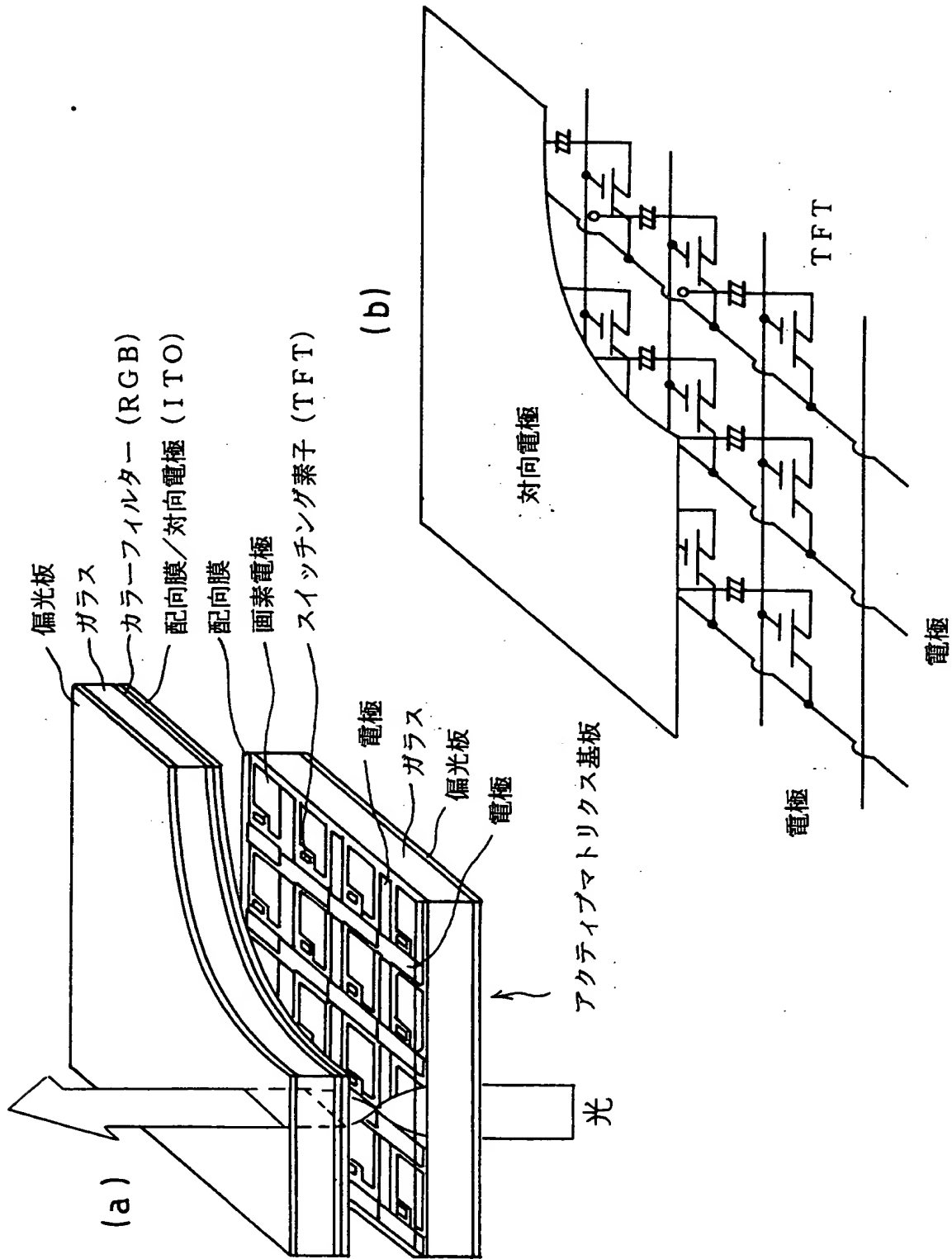
【図 4】



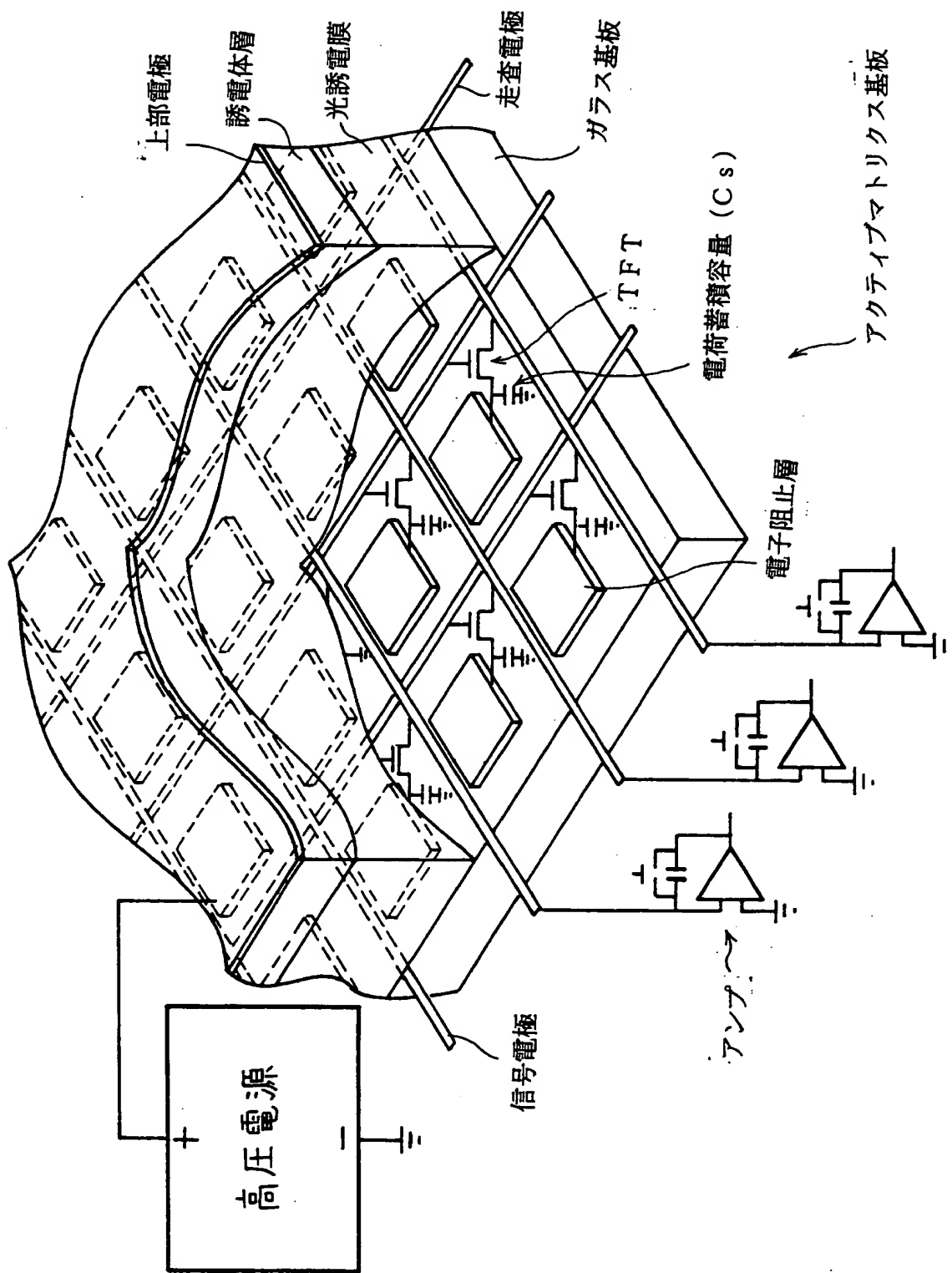
【図 5】



【図 6】



【図 7】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 電極配線を厚膜化して低抵抗化することにより、例えば表示装置や撮像装置に好適に使用することができるアクティブマトリクス基板、およびその製造方法を提供する。

【解決手段】 アクティブマトリクス基板は、ゲート電極 2 とソース電極 6 とが格子状に配列されてなる電極配線と、少なくとも該電極配線上に形成され、ソース電極 6 上の所定の領域に開口部 1 1 a を有する絶縁保護膜と、上記開口部 1 1 a におけるソース電極 6 上に積層された金属層とを備えている。従って、ソース電極 6 上に金属層が積層されているので、該金属層によってソース電極 6 の厚膜化を容易に図ることができ、ソース電極 6 を十分に低抵抗化することができる。

【選択図】 図 1

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [000005049]

1. 変更年月日 1990年 8月29日

[変更理由] 新規登録

住 所 大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号

氏 名 シャープ株式会社